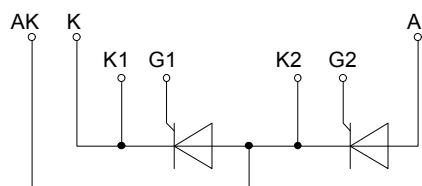
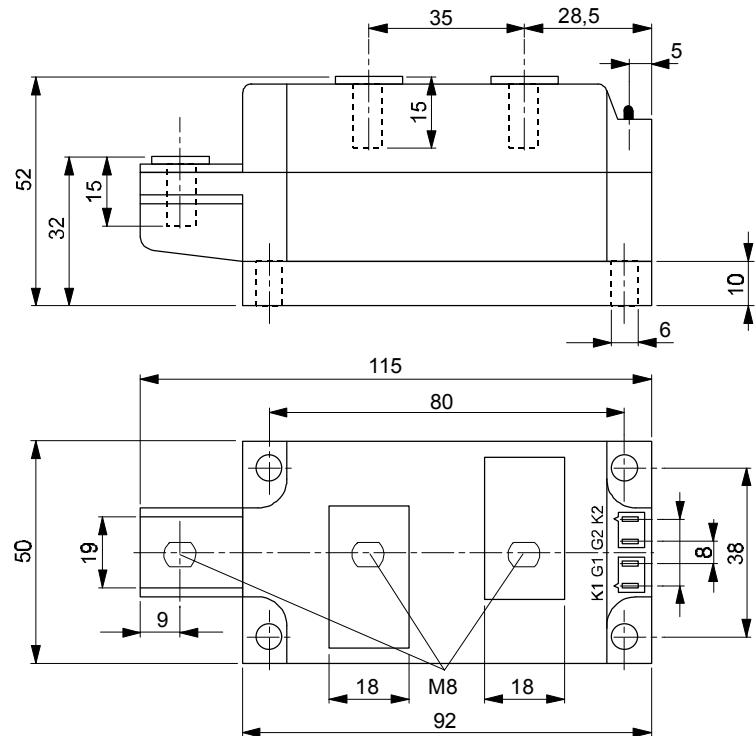


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information TT 150 N



TT 150 N

Elektrische Eigenschaften		Electrical properties					
<i>Höchstzulässige Werte</i>		<i>Maximum rated values</i>					
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung		repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$	V_{DRM}, V_{RRM}	1800 2400	2000 2600	V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung		non-repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$			V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung		non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\ max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$		+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert		RMS on-state current		I_{TRMSM}		350	A
Dauergrenzstrom		average on-state current	$t_c = 85^\circ\text{C}$ $t_c = 54^\circ\text{C}$	I_{TAVM}		150	A
Stoßstrom-Grenzwert		surge current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$	I_{TSM}	4500 4000	A A	
Grenzlastintegral		Ji^2t -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\ \text{ms}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, t_p = 10\ \text{ms}$	Ji^2dt	101000 80000	A^2s A^2s	
Kritische Stromteilheit		current	$v_D \leq 67\%$, $V_{DRM}, f_0 = 50\ \text{Hz}$	$(di/dt)_{cr}$		60	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungsteilheit		voltage	$v_L = 10\text{V}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,67\ V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	$\geq:$ F:	500 1000	$\text{V}/\mu\text{s}$ $\text{V}/\mu\text{s}$
<i>Charakteristische Werte</i>		<i>Characteristic values</i>					
Durchlaßspannung		on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, i_T = 600\ \text{A}$	v_T		max.2,6	V
Schleusenspannung		threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	$V_{T(TO)}$		1,2	V
Ersatzwiderstand		slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\ max}$	r_T		2,3	$\text{m}\Omega$
Zündstrom		gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}$	I_{GT}		max. 200	mA
Zündspannung		gate trigger voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}$	V_{GT}		max. 2	V
Nicht zündender Steuerstrom		gate non-trigger current	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 6\ \text{V}$	I_{GD}		max.10	mA
Nicht zündende Steuerspannung		gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = 0,5\ V_{DRM}$	V_{GD}		max.0,25	V
Haltestrom		holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}, R_A = 5\ \Omega$	I_H		max. 300	mA
Einraststrom		latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, v_D = 6\ \text{V}, R_{GK} >= 10\ \Omega$ $i_{GM} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}, t_g = 20\ \mu\text{s}$	I_L		max.1,2	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom		forward off-state and reverse currents	$t_{vj} = t_{vj\ max}, v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$	i_D, i_R		max. 50	mA
Zündverzug		gate controlled delay time	$t_{vj}=25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1\ \text{A}, di_G/dt = 1\ \text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}		max. 4	μs
Freiwerdezeit		circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Er./see Techn. Inf.	t_q		typ.300	μs
Isolations-Prüfspannung		insulation test voltage	RMS, $f = 50\ \text{Hz}, t = 1\ \text{min}$	V_{ISOL}		3	kV
<i>Thermische Eigenschaften</i>		<i>Thermal properties</i>					
Innerer Wärmewiderstand		thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^\circ\text{el.sinus: pro Modul/per module}$ DC: $\quad\quad\quad$ pro Zweig/per arm pro Modul/per module pro Zweig/per arm	R_{thJC}		max.0,065	$^\circ\text{C}/\text{W}$
			pro Modul/per module pro Zweig/per arm			max.0,130	$^\circ\text{C}/\text{W}$
						max.0,062	$^\circ\text{C}/\text{W}$
						max.0,124	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand		heatsink	R_{thCK}			max.0,02	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrschiichttemperatur		max. junction temperature	$t_{vj\ max}$			125	°C
Betriebstemperatur		operating temperature	$t_{c\ op}$			-40...+125	°C
Lagertemperatur		storage temperature	t_{stg}			-40...+130	°C
<i>Mechanische Eigenschaften</i>		<i>Mechanical properties</i>					
Gehäuse, siehe Seite		case, see page					1
Si-Elemente mit Druckkontakt		Si-pellet with pressure contact					
Innere Isolation		internal insulation					AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung		mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1		6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse		terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2		12	Nm
Gewicht		weight		G		800	g
Kriechstrecke		creepage distance				17	mm
Schwingfestigkeit		vibration resistance	$f = 50\ \text{Hz}$			5 . 9,81	m/s^2

TT 150 N

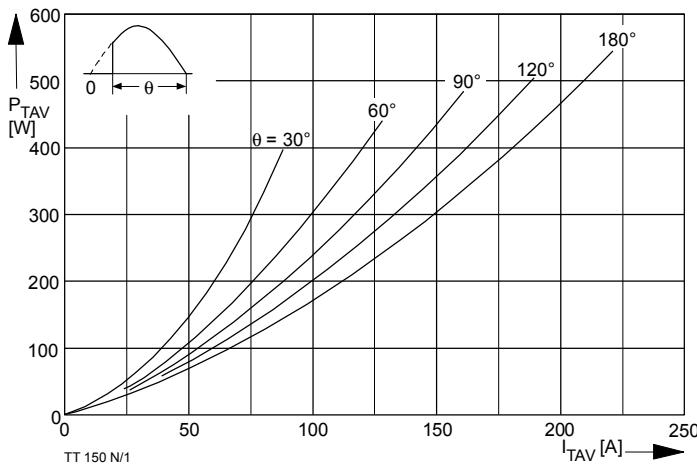


Bild / Fig. 1

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

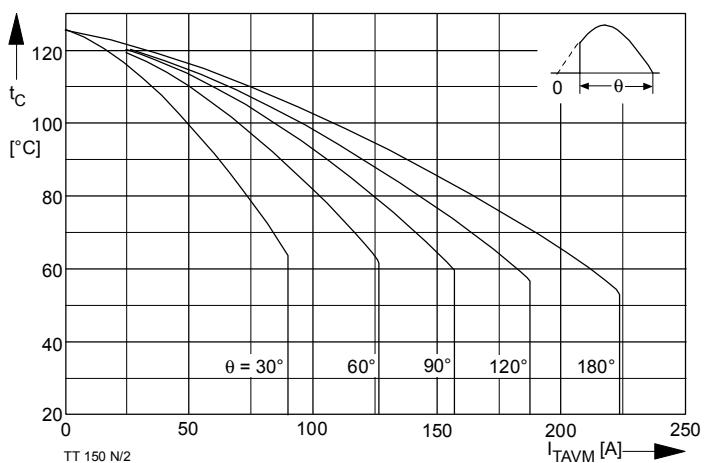


Bild / Fig. 2

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
 Strombelastung je Zweig / current load per arm
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

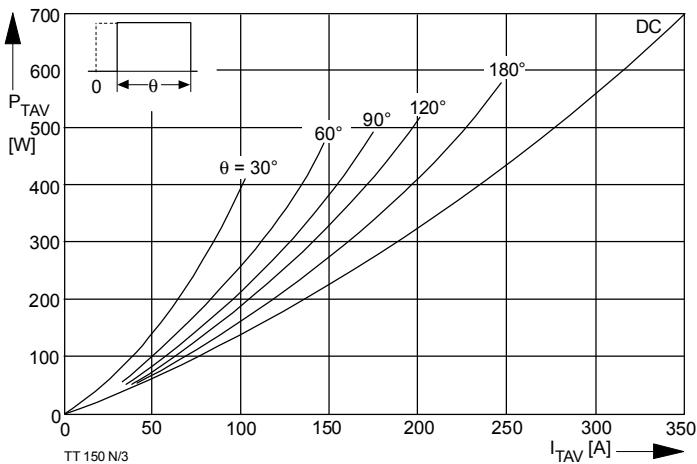


Bild / Fig. 3

Durchlaßverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm
 $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

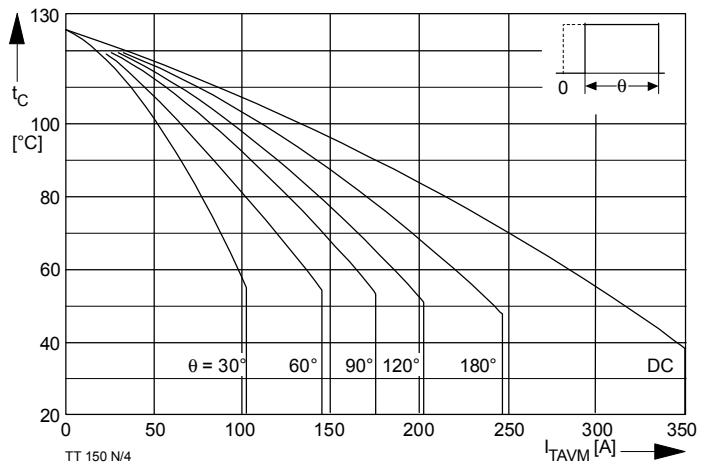


Bild / Fig. 4

Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
 Strombelastung je Zweig / current load per arm
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

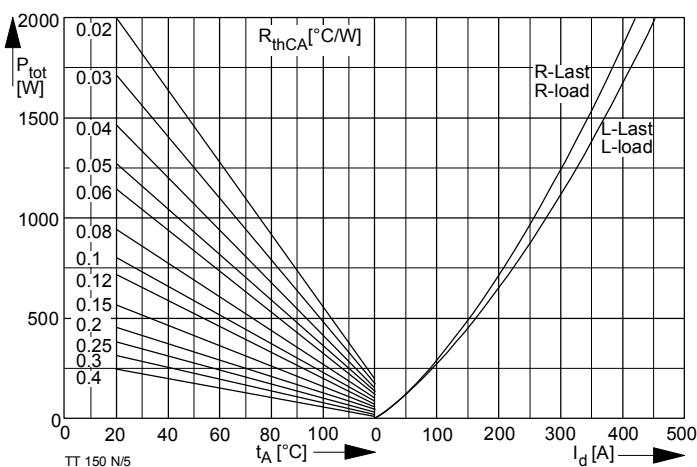


Bild / Fig. 5

B2 - Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
 Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
 Gesamtverlustleist. der Schaltung / total power dissip. of the circuit P_{tot}
 Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

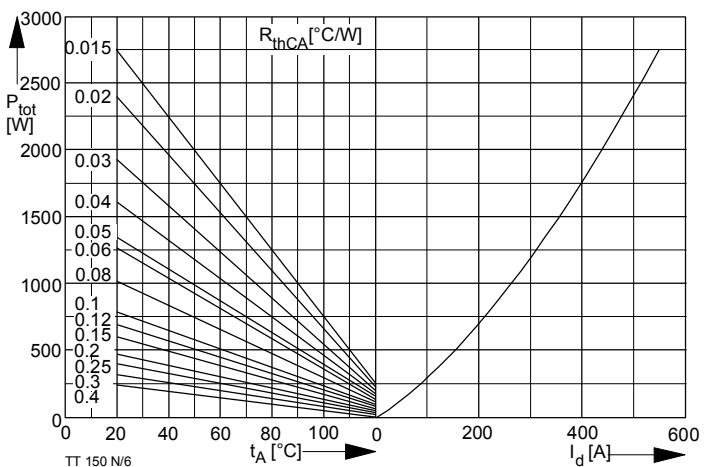


Bild / Fig. 6

B6 - Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
 Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_d
 Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
 Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung / thermal resistance case to ambient R_{thCA}

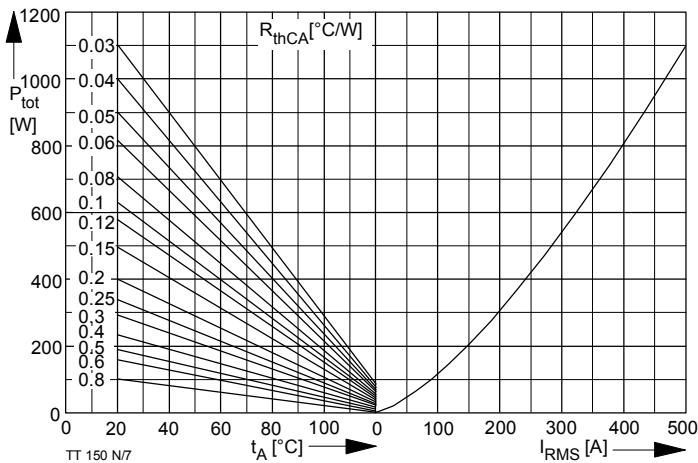


Bild / Fig. 7

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum ratet RMS current I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

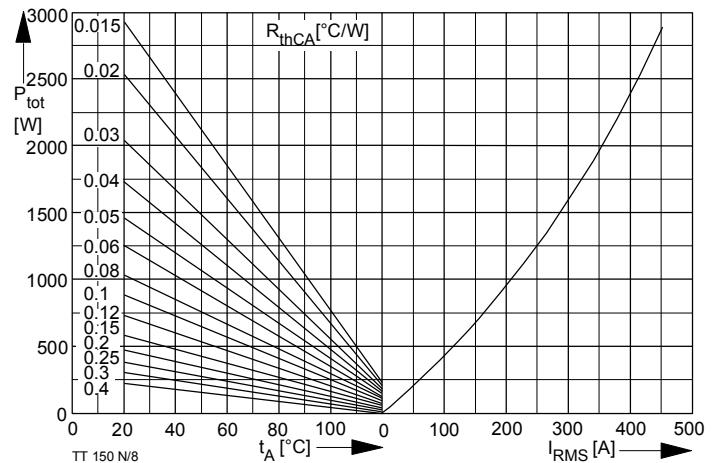


Bild / Fig. 8

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Effektivstrom je Phase / Maximum ratet RMS current per phase I_{RMS}
Gesamtverlustleist. der Schaltung / Total power dissip. of the circuit P_{tot}
Parameter: Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R_{thCA}

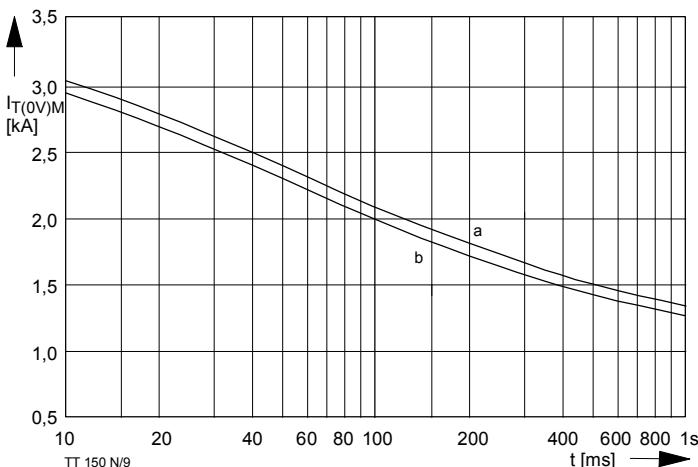


Bild / Fig. 9

Grenzstrom je Zweig $I_{T(0V)M}$: Belastung aus Leerlauf, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Maximum overload on-state current per arm $I_{T(0V)M}$: Surge current under no-load conditions, $V_R = 0,8 V_{RRM}$
a - $t_A = 35^\circ\text{C}$, verstärkte Luftkühlung / forced cooling
b - $t_A = 45^\circ\text{C}$, Luftseltbstkühlung / natural cooling

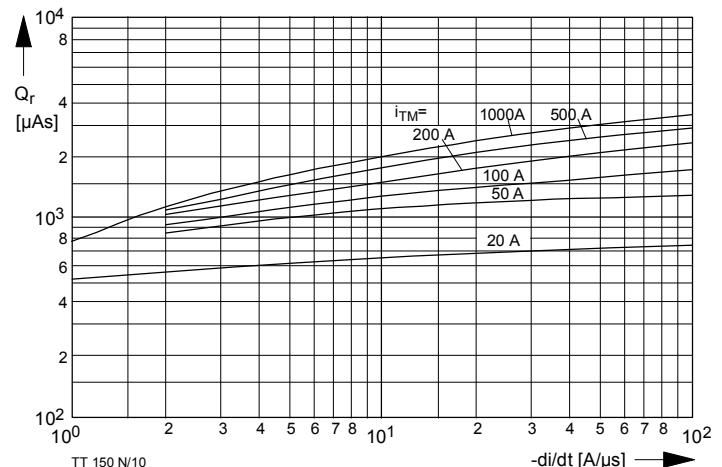


Bild / Fig. 10

Spererverzögerungsladung / Recovery charge $Q_r = f(-di/dt)$
 $t_{vj} = t_{vmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

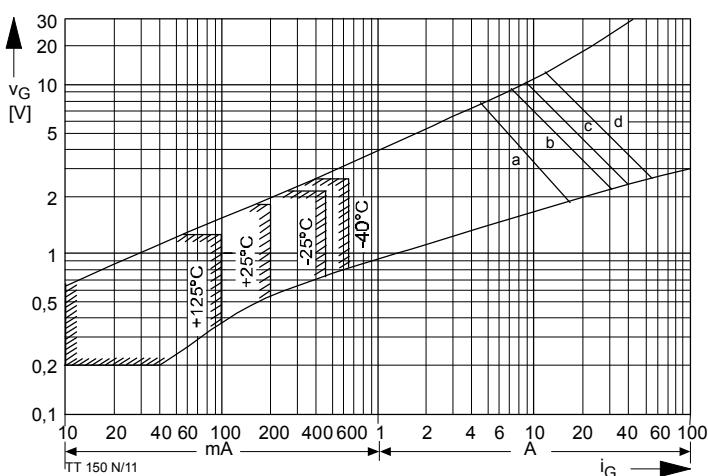


Bild / Fig. 11

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas, $v_G = f(i_G)$, $v_D = 6 \text{ V}$
Parameter:
Steuerimpulsdauer / Pulse duration t_g [ms] a b c d
Höchstzulässige Spitzesteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power [W] 40 80 100 150

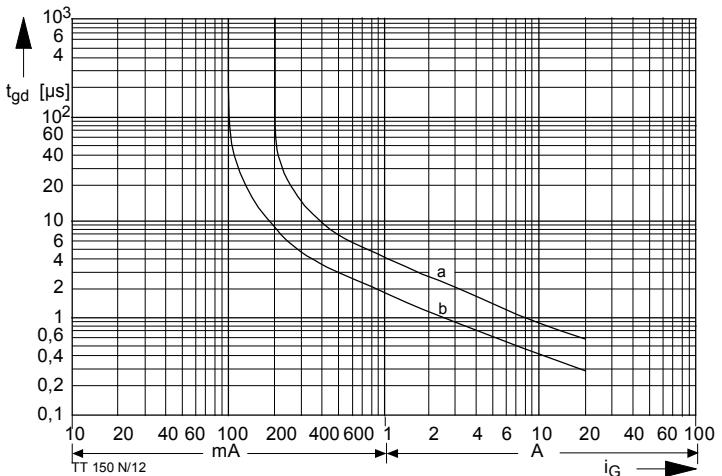


Bild / Fig. 12

Zündverzug/Gate controlled delay time t_{gd} ,
DIN 41787, $t_a = 1 \mu\text{s}$, $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$.
a - äußerster Verlauf/limiting characteristic
b - typischer Verlauf/typical characteristic

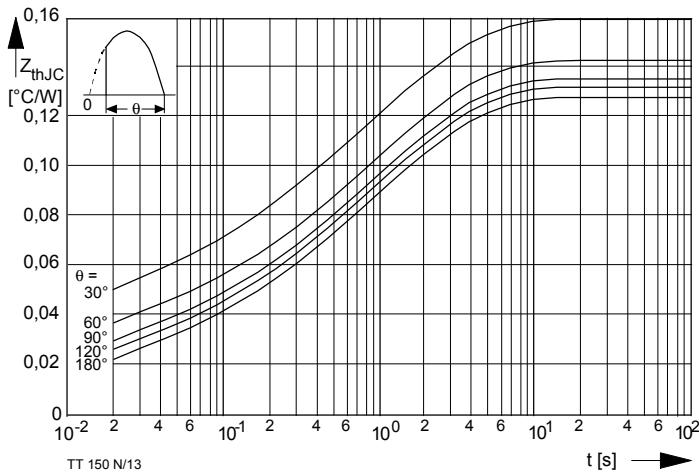


Bild / Fig. 13

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

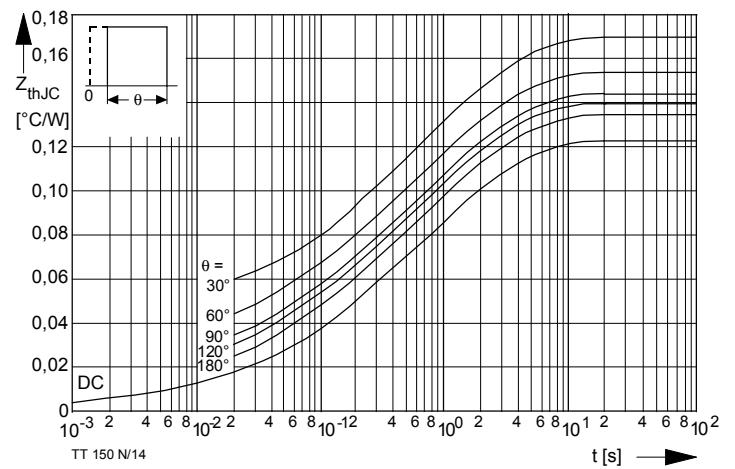


Bild / Fig. 14

Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{(th)JC} = f(t)$
Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	0,0031	0,0097	0,0257	0,0429	0,0426		
τ_n [s]	0,0009	0,008	0,11	0,61	3,06		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$